

RXファミリ

フラッシュモジュール Firmware Integration Technology

要旨

本アプリケーションノートは Firmware Integration Technology (FIT)を使ったフラッシュモジュールについて説明します。以降、本モジュールをフラッシュ FIT モジュールと称します。

本 FIT モジュールを使って、セルフプログラミングを使ったフラッシュの書き換え機能をユーザアプリケーションに容易に組み込むことができます。セルフプログラミングは、シングルチップモードで実行中に内蔵フラッシュメモリを書き換えるための機能です。本アプリケーションノートでは、フラッシュ FIT モジュールの使用、およびユーザアプリケーションへの取り込みについて説明します。

フラッシュ FIT モジュールは RX600 シリーズ、RX200 シリーズ対象のシンプルフラッシュ API とは異なります(R01AN0544)。

対象デバイス

- RX110、RX111、RX113 グループ
- RX130 グループ
- RX230、RX231 グループ
- RX23T、RX24T グループ
- RX24U グループ
- RX64M グループ
- RX65N、RX651 グループ
- RX66T グループ
- RX71M グループ
- RX72T グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

対象コンパイラ

- Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family
- GCC for Renesas RX
- IAR C/C++ Compiler for Renesas RX

関連アプリケーションノート

- Firmware Integration Technology ユーザーズマニュアル(R01AN1833)
- ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685)

目次

	I 要	
1.1	機能説明	4
2 ΔΙ	PI 情報	5
2.1	ハードウェアの要求	5
2.2	ソフトウェアの要求	
2.3	制限事項	
2.4	対応ツールチェーン	
2.5	ヘッダファイル	
2.6	整数型	
2.7		
2.8	コンパイル時の設定	
2.9	コードサイズ	
2.10		
2.11		
2.12		
2.13		
2.14	RAM からコードを実行してコードフラッシュを書き換える	15
2.	14.1 Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family を使用する場合	15
2.	14.2 GCC for Renesas RX を使用する場合	
2.	14.3 IAR C/C++ Compiler for Renesas RX を使用する場合	18
2.15	, コードフラッシュからコードを実行してコードフラッシュを書き換える	19
2.16	6 BGO モードでの動作	19
2.17	′ デュアルバンクの動作	20
2.18		
2.	18.1 BGO モードでのデータフラッシュの動作	
	18.2 BGO モードでのコードフラッシュの動作	
	18.3 コードフラッシュの動作と割り込み	
2.	18.4 エミュレータのデバッグ設定	26
0 41		07
	PI 関数	
3.1	概要	
3.2	R_FLASH_Open()	
3.3	R_FLASH_Close()R FLASH Erase()	
3.4 3.5	R_FLASH_BlankCheck()	
3.5 3.6	R_FLASH_Write()	
3.7	R_FLASH_Control()	
3.8	R_FLASH_GetVersion ()	
3.0	IV_I LAGI1_GetVetSioti ()	44
4. デ	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	45
4.1	flash_demo_rskrx113	
4.2	flash_demo_rskrx231	
4.3	flash_demo_rskrx23t	
4.4	flash_demo_rskrx130	
4.5	flash_demo_rskrx24t	
4.6	flash_demo_rskrx65n	
4.7	flash_demo_rskrx24u	
4.8	flash_demo_rx65n2mb_bank1_bootapp / _bank0_otherapp	
4.9	flash_demo_rskrx64m	48
4.10	flash_demo_rskrx64m_runrom	49
4.11	 	
4.12		
4.13		
4.14	- デモのダウンロード方法	51

フラッシュモジュール Firmware Integration Technology

5.	参考ドキュメント	. 52
⊐ <i>L</i> -=1	r≒⊐ ¢ ⊋	5 2

1. 概要

フラッシュ FIT モジュールを使って、内蔵フラッシュ領域のプログラムおよびイレーズを簡単に行えます。本モジュールはコードフラッシュおよびデータフラッシュともにサポートしています。ブロッキング、またはノンブロッキング BGO モードでプログラムおよびイレーズが行えます。ブロッキングモードで、書き換え関数、またはイレーズ関数が呼び出された場合、関数は動作が完了するまで復帰しません。BGO (バックグラウンドオペレーション) モードでは、API 関数は、処理を開始した直後に復帰します。コードフラッシュでの動作中に、ユーザアプリケーションによってコードフラッシュ領域にアクセスすることはできません。コードフラッシュ領域にアクセスしようとした場合、シーケンサはエラー状態に遷移します。BGO モードでは、コードフラッシュとデータフラッシュのいずれで動作している場合でも、ユーザは動作の完了をポーリングするか、フラッシュ割り込みのコールバック関数を提供(MCU がフラッシュ割り込みをサポートしている場合)する必要があります。

1.1 機能説明

フラッシュ FIT モジュールでサポートしている機能を以下に示します。

- ブロッキング、またはノンブロッキング BGO モードでのコードフラッシュおよびデータフラッシュ のイレーズ、プログラム、ブランクチェック
- アクセスウィンドウ、あるいはロックビットによる領域の保護
- スタートアップ領域保護。この機能は、コードフラッシュのブロック 0~7 を安全に書き換えるため の機能です。

2. API 情報

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

2.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

● フラッシュ

2.2 ソフトウェアの要求

本 FIT モジュールは以下のパッケージに依存しています。

● ルネサスボードサポートパッケージ(r_bsp) v.5.00 以降のバージョン

2.3 制限事項

- 本 API のコードは再入不可で、複数関数の呼び出しが同時に発生しないように保護します(RESET は対象外)。
- コードフラッシュの書き換え中は、コードフラッシュにアクセスできません。コードフラッシュを書き換えるときは、アプリケーションコードは RAM から実行するようにしてください。

2.4 対応ツールチェーン

本 FIT モジュールは下記ツールチェーンで動作確認を行っています。

Renesas RX Toolchain v.3.01.00

2.5 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は r_flash_rx_if.h に記載されています。このファイルは、Flash FIT を使用するすべてのファイルに含める必要があります。

r_flash_rx_config.h ファイルで、ビルド時に設定可能なコンフィギュレーションオプションを定義します。

2.6 整数型

コードをわかりやすく、また移植が容易に行えるように、本プロジェクトでは ANSI C99 (Exact width integer types (固定幅の整数型)) を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

2.7 フラッシュのタイプと機能

フラッシュドライバは使用される技術およびシーケンサによって3つのタイプに分かれます。コンパイル 後のフラッシュドライバのサイズはフラッシュのタイプが基準となります(2.9 参照)。

フラッシュタイプ1

RX110*、RX111、RX113、RX130 RX230、RX231、RX23T*、RX24T、RX24U * データフラッシュはありません。

フラッシュタイプ3

RX64M、RX66T、RX71M、RX72T

フラッシュタイプ 4

RX651*、RX65N*

* コードフラッシュメモリ容量が 1M バイト以下の製品ではデータフラッシュはありません。

MCU によってフラッシュタイプが異なるため、すべての MCU ですべてのフラッシュのコマンドや機能が使用できるわけではありません。 $r_flash_rx_if.h$ で#define(下記参照)を使って、各 MCU で使用可能な機能が定義されます。

2.8 コンパイル時の設定

本モジュールのコンフィギュレーションオプションの設定は、r_flash_rx_config.h で行います。 オプション名および設定値に関する説明を、下表に示します。

コンフィギュレーション	ノオプション	√ (r_flash_rx_config.h) (1/2)
定義	デフォルト値	説明
FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE	1	この定義を"1"に設定するとパラメータチェック処理 のコードを生成し、"0"に設定すると生成しません。
FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE	0	データフラッシュのみを使用する場合は"0"に設定してください。 "1"に設定するとコードフラッシュ領域を書き換えるためのコードを生成します。コードフラッシュを書き換える際は、RAM からコードを実行する必要があります。ただし、フラッシュタイプ3(ユーザーズマニュアル ハードウェア編の表 63.18 参照)とコードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の RX65N グループ(ユーザーズマニュアル ハードウェア編の表 59.15 参照)には制限付きで例外があります。 RAM からコードを実行するためのコードおよびリンカの設定については、2.14 を参照してください。 本 FIT モジュールの BGO モードに関する定義につい
FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO	0	ては、2.16を参照してください。 この定義を"0"に設定すると、処理が完了するまで、データフラッシュの API 関数はブロックされます。 "1"に設定するとモジュールは BGO モード (BGO 動作/割り込み) になります。BGO モードでは、API 関数はデータフラッシュでの動作開始後すぐに復帰します。動作完了の通知はコールバック関数を使って行います。 FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE が"1"の場合、FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO と同じ設定にしてください。
FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO	0	この定義を"0"に設定すると、処理が完了するまで、コードフラッシュの API 関数はブロックされます。 "1"に設定するとモジュールは BGO モード (BGO 動作/割り込み) になります。BGO モードでは、API 関数はコードフラッシュでの動作開始後すぐに復帰します。動作完了の通知はコールバック関数を使って行います。コードフラッシュの書き換え時、可変ベクタテーブルとそれに対応する割り込み処理を、前もってコードフラッシュ以外の場所に配置する必要があります。2.18 の使用上の注意を参照してください。 FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE が"1"の場合、FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO と同じ設定にしてください。
FLASH_CFG_CODE_FLASH_RUN_FROM_ROM	0	この定義はフラッシュタイプ3およびコードフラッシュメモリ容量が1.5Mバイト以上のRX65Nグループの製品に適用されます。 また、FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLEが1に設定されている場合のみ有効です。 RAMのコードを実行しながら、コードフラッシュを書き換える場合は"0"に設定してください。

コードフラッシュの別のセグメントでコードを実行し
ながら、コードフラッシュを書き換える場合は"1"に
してください(2.15 参照)。

2.9 コードサイズ

本モジュールの ROM サイズ、RAM サイズ、最大使用スタックサイズを下表に示します。フラッシュタイプ毎に代表して 1 デバイスずつ掲載しています。

ツールチェーン(セクション 2.4 に記載)でのコードサイズは、最適化レベル 2、およびコードサイズ重視の最適化を前提としたサイズです。ROM (コードおよび定数) と RAM (グローバルデータ) のサイズは、本モジュールのコンフィギュレーションヘッダファイルで設定される、ビルド時のコンフィギュレーションオプションによって決まります。

下表の値は下記条件で確認しています。

モジュールリビジョン: r_flash_rx Rev.4.00

コンパイラバージョン: Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family V3.01.00

(統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)

GCC for Renesas RX 4.08.04.201801

(統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)

IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.10.01

(統合開発環境のデフォルト設定)

コンフィグレーションオプション:差分となるコンフィグレーションオプションの設定は各表に記載 その他のコンフィグレーションオプションはデフォルト設定

フラッシュタイプ1:ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(最大サイズ)								
デバイス	分類	使用メモリ	使用メモリ					
		Renesas Compiler		GCC		IAR Compiler		
		パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	
		チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	
RX130	ROM	860 バイト	833 バイト	1880 バイト	1724 バイト	_	_	
	RAM	5391 バイト		10767 バイト		_		
	スタック	972 バイト		_		_		

コンフィギュレーションオプション:

 ${\sf FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE}\ 0: {\it N} {\it \exists} \, {\it J} = {\it v} {\it D} \, {\it x} \, {\it v} \, {\it v} \, {\it x} \, {\it v} \, {\it v} \, {\it x} \, {\it v} \, {\it v} \, {\it x} \, {\it v} \, {\it v} \, {\it x} \, {\it v} \,$

FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO 1

FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE 1

FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO 1

	フラッシュタイプ1:ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(最小サイズ)							
デバイス	分類	使用メモリ	使用メモリ					
		Renesas Compiler		GCC		IAR Compiler		
		パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	
		チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	
RX130	ROM	1828 バイト	1713 バイト	3790 バイト	3524 バイト	2655 バイト	2519 バイト	
	RAM 73バイト		76 バイト		55 バイト			
	スタック	964 バイト		_		1036 バイト		

コンフィギュレーションオプション:

FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE 0: パラメータチェックなし、1: パラメータチェックあり

FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO 0

FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE 0

FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO 0

フラッシュタイプ 3:ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(最大サイズ)							
デバイス	分類	使用メモリ					
		Renesas Compiler		GCC	GCC		
		パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ
		チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし
RX64M	ROM	557 バイト	544 バイト	1172 バイト	1140 バイト	_	_
	RAM 5993 バイト			12604 バイト		_	
	スタック	48 バイト		-		_	

コンフィギュレーションオプション:

FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE 0: パラメータチェックなし、1: パラメータチェックあり FLASH_CFG_CODE/DATA_FLASH_BGO 1 FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE 1

	フラッシュタイプ 3:ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(最小サイズ)							
デバイス	デバイス 分類 使用メモリ							
		Renesas Compile	er	GCC	GCC		IAR Compiler	
		パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	
		チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	
RX64M	ROM	2147 バイト	2017 バイト	4564 バイト	4388 バイト	3639 バイト	3488 バイト	
	RAM	65 バイト		332 バイト		48 バイト		
	スタック	32 バイト		-		72 バイト		

コンフィギュレーションオプション:

FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE 0: パラメータチェックなし、1: パラメータチェックあり FLASH_CFG_CODE/DATA_FLASH_BGO 0

FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE 0

	フラッシュタイプ 4:ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(最大サイズ)							
デバイス	分類	使用メモリ	使用メモリ					
	Renesas Compiler		GCC		IAR Compiler			
		パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	
		チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	
RX65N	ROM	487 バイト	474 バイト	972 バイト	948 バイト	_	_	
	RAM	6109 バイト		12520 バイト		_		
	スタック	44 バイト		_		_		

コンフィギュレーションオプション:

FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE 0: パラメータチェックなし、1: パラメータチェックあり FLASH_CFG_CODE/DATA_FLASH_BGO 1

	フラッシュタイプ 4:ROM、RAM およびスタックのコードサイズ(最小サイズ)							
デバイス	デバイス 分類 使用メモリ							
		Renesas Compiler (GCC		IAR Compiler		
		パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	
		チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	チェックあり	チェックなし	
RX65N	ROM	1978 バイト	1848 バイト	4132 バイト	3964 バイト	3362 バイト	3211 バイト	
	RAM 61 バイト		328 バイト		47 バイト			
	スタック	28 バイト		-		68 バイト		

コンフィギュレーションオプション:

FLASH_CFG_PARAM_CHECKING_ENABLE 0: パラメータチェックなし、1: パラメータチェックあり FLASH_CFG_CODE/DATA_FLASH_BGO 0

2.10 引数

API 関数の引数である構造体を示します。この構造体は、API 関数のプロトタイプ宣言とともに $r_{flash_rx_if.h}$ に記載されています。API 関数については 3 章で説明します。

2.11 戻り値

API 関数の戻り値を示します。この列挙型は、r_flash_rx_if.h に記載されています。

```
/* Flash FITエラーコード */
typedef enum_flash_err
FLASH\_SUCCESS = 0,
                   /* フラッシュモジュールはビジー状態 */
FLASH_ERR_BUSY,
FLASH_ERR_ACCESSW,
                    /* アクセスウィンドウのエラー */
                    /* フラッシュの動作失敗; プログラミングエラー、
FLASH_ERR_FAILURE,
                      イレーズエラー、ブランクチェックエラーなど */
FLASH ERR_CMD_LOCKED, /* タイプ 3 - 周辺機能はコマンドロック状態 */
FLASH_ERR_LOCKBIT_SET, /* タイプ 3 - ロックビットに起因するプログラム/イレーズエラー */
FLASH_ERR_FREQUENCY,
                   /* タイプ 3 - 不正な周波数(4-60Mhz) */
FLASH_ERR_BYTES,
                    /* 無効なバイト数 */
FLASH_ERR_ADDRESS,
                 /* 無効なアドレス */
/* ブロック数を指定する引数が無効です。*/
FLASH_ERR_BLOCKS,
FLASH_ERR_PARAM, /* 不正な引数 */
FLASH_ERR_NULL_PTR, /* 要求された引数がありません。 */
FLASH_ERR_UNSUPPORTED, /* このフラッシュタイプではコマンドはサポートされていません。 */
FLASH_ERR_SECURITY, /* タイプ 4 - FAW.FSPR による保護に起因するプログラム/イレーズエラー。 */
                   /* 時間切れです。 */
FLASH_ERR_TIMEOUT,
FLASH_ERR_ALREADY_OPEN /* Close()を呼び出さず、Open()を2回呼び出した。 */
} flash_err_t;
```

2.12 Flash FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

- (1) e² studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 e² studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e² studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) e² studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 e² studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e² studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。
- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e² studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合 CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーション ノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

2.13 既存のユーザプロジェクトと組み合わせた使用方法

本モジュールは、BSPのスタートアップ無効化機能を使用することによって、既存のユーザプロジェクトと組み合わせて使用することが出来ます。

BSP のスタートアップ無効化機能は、新たにプロジェクトを作成せずに、既存のユーザプロジェクトに本モジュールやその他の各周辺の FIT モジュールを追加して使用するための機能です。

既存のユーザプロジェクトに BSP と本モジュール(必要であればその他の各周辺の FIT モジュール)を組み込みます。BSP を組み込む必要はありますが、BSP で行うすべてのスタートアップ処理が無効となるため、既存のユーザプロジェクトのスタートアップ処理と組み合わせて、本モジュールやその他の各周辺の FIT モジュールを使用することができます。

BSP のスタートアップ無効化機能を使用するためには幾つかの設定と注意点があります。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685)」を参照ください。

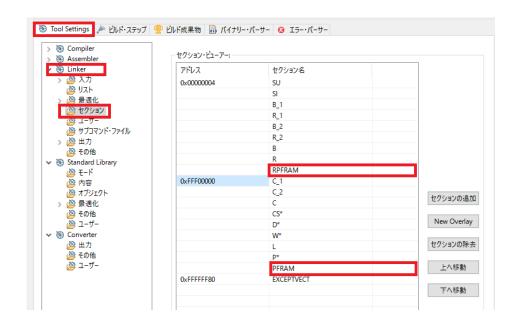
2.14 RAM からコードを実行してコードフラッシュを書き換える

コードフラッシュを書き換えるための API 関数を保持するために、RAM およびコードフラッシュにセクションを作成する必要があります。これは、シーケンサがコードフラッシュのコードを実行中にコードフラッシュのプログラム、あるいはイレーズが行えないためです(タイプ3では例外の場合あり)。RAM のセクションは、リセット後に初期設定する必要があります。

コードフラッシュの書き換えを有効にするために、r_flash_rx_config.h で

"FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE"を"1"に設定します。これはコードフラッシュを書き換える場合に のみ適用されます。

- 2.14.1 Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family を使用する場合
- コンパイラとして Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family を使用する場合について示します。
- リンカのセクションの設定とコードフラッシュから RAM へのマッピングは e^2 studio で行う必要があります。
- 1. RAM 領域に新規セクション"RPFRAM"を追加します。
- 2. コードフラッシュ領域に新規セクション"PFRAM"を追加します。

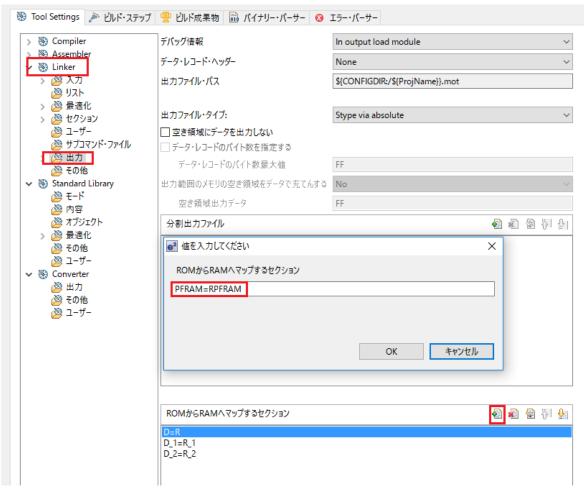


注: ご使用の e^2 studio バージョンにより、P セクションまたは P*セクションが存在するものがあります。上記のように P*セクションがある場合、PFRAM セクションを別で指定する必要はありません。(指定した場合はワーニングが発生します。)

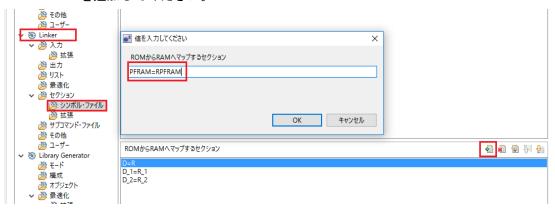
 e^2 studio v6.0.0 以降を使用している場合、そのままではセクション・ビューアーは表示されません。セクション・ビューアーを表示するには、[セクション]エントリの右側にある[...]ボタンをクリックします。



3. リンカ出力オプションに "PFRAM=RPFRAM"を追加して(以下参照)、コードフラッシュのセクション (PFRAM) アドレスを RAM のセクション (RPFRAM) アドレスにマップします。これは v6.0.0 より前の e^2 studio では「ツール設定」タブで「Linker」の「出力」セクションから行います。



e² studio v6.0.0 以降を使用している場合、リンカ > セクション > シンボルファイルで "PFRAM = RPFRAM"を追加してください。



4. ここまででリンカが正しく設定され、適切な API コードが RAM に割り当てられました。コードフラッシュから RAM へのコードのコピーは、R_FLASH_Open()関数の呼び出し時に自動的に行われます。これが API 関数を呼び出す前に行われていないと、MCU は初期化していない RAM にジャンプすることになります。

5. 割り込みコールバック関数とコードフラッシュで動作するコードは FRAM セクション内に配置する必要 があります。

#pragma section FRAM

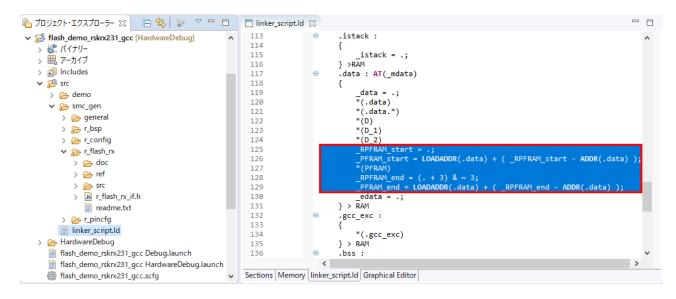
/* コードフラッシュ上で動作する関数(および割り込みコールバック)はここに置く */ #pragma

6. コードフラッシュから RAM ヘコピーするコードに switch 文のコードが含まれる場合、switch 文のコー ドが分岐テーブルに展開されてしまうと RAM にコピーされません。確実に FRAM セクション内に配置 されるように以下の設定を行います。



2.14.2 GCC for Renesas RX を使用する場合

- コンパイラとして GCC for Renesas RX を使用する場合について示します。
- リンカの設定は e² studio で生成されるリンカ設定ファイルを編集する必要があります。
- 1. リンカ設定ファイル(linker_script.ld)に以下を追加します。



※GCC for Renesas RX ではリトルエンディアン動作のみ確認しています。

2.14.3 IAR C/C++ Compiler for Renesas RX を使用する場合

コードフラッシュの書き換えはサポートしていません。

データフラッシュの書き換えのみサポートしています。

2.15 コードフラッシュからコードを実行してコードフラッシュを書き換える

フラッシュタイプ 3 およびコードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の RX65N グループの製品では、一定の条件を満たせば、コードフラッシュからコードを実行中にコードフラッシュを書き換えることができます。コードフラッシュは基本的に 2 つの領域に分けられます。片方の領域でコードを実行し、他方の領域でプログラム/イレーズを行います。領域のサイズは MCU のコードフラッシュの容量によって異なります。領域の境界については、それぞれのユーザーズマニュアル ハードウェア編で表 63.16(RX64M)および表 63.18(RX71M)を参照してください。この機能をサポートするのは、コードフラッシュ領域の大きい MCU のみです。コードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の RX65N グループの製品では、境界はバンクの境界と一致します。

この方法を使用する場合、r_flash_rx_config.h で FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE、FLASH_CFG_CODE_FLASH_RUN_FROM_ROM の設定を"1"にしてください。

FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO(完了待ち)の設定は"0"でも"1"でも構いませんが、データフラッシュの BGO 設定と一致する必要があります。

2.14 の方法は使用せず、コードの実行元とコードの実行先が異なるように設定してください。

2.16 **BGO モードでの動作**

BGO モードは、通常、ドライバがノンブロッキングモードになることを言います。ノンブロッキング モードとは、コードフラッシュの動作がバックグラウンドで実行中に、RAM からの命令を実行できるモー ドです。フラッシュタイプ 3 と RX65N グループのユーザーズマニュアル ハードウェア編では、BGO モードは、コードフラッシュの一方のセクションでコードを実行し、他方のセクションでプログラムが実行 できる(2.14 参照)モードとして定義されています。

r_flash_config.h 内の#define 定義は、割り込みの使用やブロッキングモードでの動作に関わらず、通常のBGO の定義を使用しますので、フラッシュタイプ 3 と RX65N グループ(コードフラッシュメモリ容量が1.5M バイト以上の製品)に対応するため、BGO 機能への新規定義"FLASH_CFG_CODE_FLASH_RUN_FROM_ROM"が提供されます。

BGO モードで動作している場合、API 関数はブロックされず、すぐに復帰します。ユーザは、フラッシュ領域で処理中の動作が完了するまで、その領域にアクセスしないでください。アクセスした場合、シーケンサはエラー状態になり、動作は正常に完了しません。

動作の完了は FRDYI 割り込みによって示されます。FRDYI 割り込み処理で処理の完了が確認され、コールバック関数が呼び出されます。コールバック関数を登録するには、

"FLASH_CMD_SET_BGO_CALLBACK"コマンドを使って、R_FLASH_Control 関数を呼び出します。完了のステータスを示すイベントがコールバック関数に渡されます。一部の MCU 固有のイベントは
"r flash rx if.h"で以下のように定義されます。

```
typedef enum _flash_interrupt_event
{
    FLASH_INT_EVENT_INITIALIZED,
    FLASH_INT_EVENT_ERASE_COMPLETE,
    FLASH_INT_EVENT_WRITE_COMPLETE,
    FLASH_INT_EVENT_BLANK,
    FLASH_INT_EVENT_NOT_BLANK,
    FLASH_INT_EVENT_TOGGLE_STARTUPAREA,
    FLASH_INT_EVENT_SET_ACCESSWINDOW,
```

```
FLASH_INT_EVENT_LOCKBIT_WRITTEN,
FLASH_INT_EVENT_LOCKBIT_PROTECTED,
FLASH_INT_EVENT_LOCKBIT_NON_PROTECTED,
FLASH_INT_EVENT_ERR_DF_ACCESS,
FLASH_INT_EVENT_ERR_CF_ACCESS,
FLASH_INT_EVENT_ERR_SECURITY,
FLASH_INT_EVENT_ERR_CMD_LOCKED,
FLASH_INT_EVENT_ERR_LOCKBIT_SET,
FLASH_INT_EVENT_ERR_FAILURE,
FLASH_INT_EVENT_TOGGLE_BANK,
FLASH_INT_EVENT_END_ENUM

} flash_interrupt_event_t;
```

コードフラッシュを書き換える場合、前もって、可変ベクタテーブルおよび関連する割り込みをコードフラッシュ以外の領域に配置する必要があります(フラッシュタイプ 3 とコードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の RX65N グループでは例外あり。2.15 参照。)

2.17 デュアルバンクの動作

コードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の RX65N グループの製品はリニアとデュアルバンクの 2 種類のモードで動作できます。リニアモードは標準モードで、単一のアプリケーションがコードフラッシュ外で実行されます。デュアルバンクモードでは、2 つのアプリケーションをコードフラッシュに同時に 読み込むことができます。コードフラッシュの上半分(固定ベクタテーブルが含まれる部分)に読み込まれ たアプリケーションが実行されます。アプリケーションは

R_FLASH_Control(FLASH_CMD_BANK_TOGGLE)コマンドを使って実行時に切り替えることができます。 この切り替えは、次に MCU がリセットされるまで有効にはなりません。

アプリケーション開発時は、bsp_config.h で定義される以下の2つの定数を変更する必要があります。

- BSP_CFG_CODE_FLASH_BANK_MODE: 0 // デュアルモードの場合、"0"に設定(デフォルトではありません)
- BSP_CFG_CODE_FLASH_START_BANK: 1 // アプリケーションごとで値が異なる

モードの定数はいずれのアプリケーションでも"0"に設定してください。スタートバンクは一方のアプリケーションで"1"に、もう一方では"0"に設定します。いずれのバンクもブートバンクにできます。ブート元のバンクがデバッグ設定で選択されます。



上記の例では、BSP_CFG_CODE_FLASH_START_BANK を"1"に設定してビルドしたアプリケーションがリセット時に実行されます。

セクション 2.15 で述べたように、フラッシュ FIT モジュールは、RAM から実行せずとも他方のバンクのコードフラッシュに対してイレーズおよびプログラムが行えます(r_flash_config.h の FLASH_CFG_CODE_FLASH_RUN_FROM_ROM を"1"に設定)。ただし、バンクの切り替えを行うコードは RAM から実行する必要があります。これを可能にするために、リンカのセクションテーブルに "RPFRAM2"を追加し、マッピングを次ページで示すように出力します。



注: e^2 studio v6.0.0 以降では、右上に[...]ボタンが表示されます。このボタンは、以前のバージョンのようなセクション・ビューアーを表示するためには押す必要があります。



注: e^2 studio v6.0.0 以降では、[ROM から RAM ヘマップするセクション]はリンカ > セクション > シンボルファイルにありリンカ > 出力ではありません。

エミュレータを使用する場合は、BSP_CFG_CODE_FLASH_START_BANK を"0"に設定してビルドしたアプリケーションをダウンロードします。これを実施すると、以下のようにスタートアップタブに追加されます。



2つ目のアプリケーションのオフセットは-1Mbのオフセットを付ける必要があります。-1Mbのオフセットは 1Mbの2の補数(FFF00000)にしてください (開始アドレスではありません)。これによって、2つ目のアプリケーションは、メモリ内で「リンカ/マップファイルで示される値 - 1Mb」の位置に読み込まれます。

現状の e²studio で 1 度に維持できるデバッグシンボルテーブルは 1 つのみです。そのため、どちらか一方のアプリケーションのみのロード・タイプが「イメージとシンボル」になります。デバッグセッションが停止した場合、e²studio はこのシンボルテーブルを使ってソースコードと変数を表示します。ただし、表示される内容は、その時に実行していたアプリケーションのものとは限りません。そのため、ユーザは LEDを使って実行中のアプリケーションが示されるようにすることが推奨されます。そうすることで、プログラムが一時停止した場合、表示されているソースコードが実行中のコードかどうかを判断できます。

これは、最初にアプリケーションが完璧にデバッグされ、またシンボルテーブルが必要に応じていつでも変更可能な場合、わずかな制限に過ぎません。

2.18 使用上の注意

2.18.1 BGO モードでのデータフラッシュの動作

BGO/ノンブロッキングモードでデータフラッシュを書き換える場合、コードフラッシュ、RAM、および外部メモリへのアクセスが可能です。ただし、データフラッシュの動作中は、割り込みによるアクセスも含めて、データフラッシュにアクセスしないでください。

2.18.2 BGO モードでのコードフラッシュの動作

BGO/ノンブロッキングモードでコードフラッシュを書き換える場合、外部メモリ、および RAM へのアクセスが可能です。フラッシュ FIT モジュールの API 関数がコードフラッシュの動作完了前に復帰するため、API 関数を呼び出すコードは RAM に配置します。また、その他のフラッシュコマンドを発行する前に、処理中の動作の完了を確認する必要があります。コマンドにはコードフラッシュのアクセスウィンドウの設定、ブートブロックの切り替え/スタートアップ領域フラグのトグル、コードフラッシュのイレーズ、コードフラッシュのプログラム、また、他の FIT モジュール(R01AN2191)を使ったユニーク ID の呼び出しが含まれます。

2.18.3 コードフラッシュの動作と割り込み

特定のメモリ領域に対してフラッシュが動作中の場合は、コードフラッシュ、またはデータフラッシュのその領域にはアクセスできません。そのため、フラッシュの動作中に割り込みの発生を許可する場合は、可変ベクタテーブルの配置に注意が必要です。

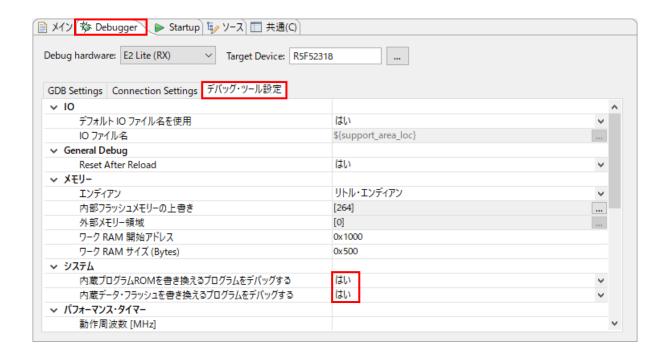
ベクタテーブルは、デフォルトでコードフラッシュに配置されます。コードフラッシュの動作中に割り込みが発生すると、割り込みの開始アドレスを取得するためにコードフラッシュにアクセスし、エラーが発生します。これに対応するために、ベクタテーブルと、発生し得る割り込みをコードフラッシュ以外の場所に配置する必要があります。また、割り込みテーブルレジスタ (INTB)も変更が必要です。

本 FIT モジュールには、ベクタテーブルおよび割り込み処理を再配置するための関数は含まれていません。ユーザシステムに応じて、ベクタテーブルと割り込みを再配置する適切な方法を検討してください。

2.18.4 エミュレータのデバッグ設定

デバッグ時にコードフラッシュ、データフラッシュに書き込まれたデータを確認する場合、次のようにデバッグ構成のデバッグツール設定を変更してください。

- 1. 「プロジェクト・エクスプローラ」においてデバッグ対象のプロジェクトをクリックします。
- 2. 「実行」→「デバッグの構成…」の順にクリックし、「デバッグ構成」ウィンドウを開きます。
- 3. 「デバッグ構成」ウィンドウで、"Renesas GDB Hardware Debugging"デバッグ構成の表示を展開し、デバッグ対象のデバッグ構成をクリックしてください。
- 4. 「Debugger」タブに切り替え、「Debugger」タブの中の「デバッグ・ツール設定」サブタブをクリックし、以下のように設定します。
 - システム
 - 内蔵プログラム ROM を書き換えるプログラムをデバッグする = "はい"
 - 内蔵データ・フラッシュを書き換えるプログラムをデバッグする = "はい"



3. API 関数

3.1 概要

本 FIT モジュールには以下の関数が含まれます。

関数	説明
R_FLASH_Open()	フラッシュ FIT モジュールを初期化します。
R_FLASH_Close()	フラッシュ FIT モジュールを終了します。
R_FLASH_Erase()	コードフラッシュ、またはデータフラッシュの指定ブロックをイ レーズします。
R_FLASH_BlankCheck()	指定したデータフラッシュ、またはコードフラッシュの領域がブランクかどうかを確認します。
R_FLASH_Write()	コードフラッシュ、またはデータフラッシュを書き換えます。
R_FLASH_Control()	状態チェック、および領域保護、スタートアップ領域保護の切り替 えを設定します。
R_FLASH_GetVersion()	本 FIT モジュールのバージョン番号を返します。

3.2 R_FLASH_Open()

フラッシュ FIT モジュールを初期化する関数です。この関数は他の API 関数を使用する前に実行される必要があります。

Format

```
flash_err_t R_FLASH_Open(void);
```

Parameters

なし

Return Values

```
FLASH_SUCCESS /*フラッシュ FIT モジュールが正常に初期化されました。*/
FLASH_ERR_BUSY /*他のフラッシュ動作が処理中です。後から再試行してください。 */
FLASH_ERR_ALREADY_OPEN: /* Close()を呼び出さず、Open()を2 回呼び出した。*/
```

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

本関数はフラッシュ FIT モジュールを初期化します。"FLASH_CFG_CODE_FLASH_ENABLE"が"1"の場合、コードフラッシュのプログラム/イレーズに必要な API 関数を RAM にコピーします(ベクタテーブルは含みません)。この関数は他の API 関数を使用する前に実行される必要があります。

Reentrant

この関数は再入不可です。

Example

```
flash_err_t err;

/* APIの初期設定 */
err = R_FLASH_Open();

/* エラーを確認 */
if (FLASH_SUCCESS != err)
{

....
}
```

Special Notes:

なし

3.3 R_FLASH_Close()

フラッシュ FIT モジュールを終了する関数です。

Format

flash_err_t R_FLASH_Close(void);

Parameters

なし

Return Values

FLASH_SUCCESS: /*フラッシュ FIT モジュールを正常に終了しました。*/

FLASH_ERR_BUSY: /*他のフラッシュ動作が処理中です。後から再試行してください。*/

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

本関数はフラッシュ FIT モジュールを終了します。フラッシュ割り込みが有効な場合はこれを無効化し、ドライバを初期化されていない状態に設定します。この関数が必要なのは、VEE(仮想 EEPROM)ドライバを使用するときのみです。その場合、R_VEE_Open()を呼び出す前に、フラッシュドライバを終了しておく必要があります(動作させてはいけません)。

Reentrant

この関数は再入不可です。

Example

Special Notes:

なし

3.4 R FLASH Erase()

コードフラッシュまたはデータフラッシュの指定したブロックをイレーズします。

Format

Parameters

block_start_address

イレーズするブロックの開始アドレスを指定します。列挙型"flash_block_address_t"は対応する MCU の"r_flash_rx¥src¥targets¥<mcu>¥r_flash_<mcu>.h"で定義されます。ブロックは各 MCU の UMH の記載と同様にラベル付けされます。例えば、RX113 の UMH ではアドレス 0xFFFFC000 に配置されているブロックはブロック 7 なので、この引数には"FLASH_CF_BLOCK_7"が渡されます。同様に、アドレス 0x00100000 に配置されているデータフラッシュブロック 0 をイレーズする場合に渡される引数は "FLASH_DF_BLOCK_0"になります。

num_blocks

イレーズ対象のブロック数を指定します。タイプ 1 では、"block_start_address + num_blocks"が、 256K の境界を越えないようにしてください。

Return Values

FLASH_SUCCESS /*正常動作(BGO モードが有効な場合、動作が正常に */

/*開始されたことを意味します。) */

FLASH_ERR_BLOCKS /*指定されたブロック数は無効です。*/ FLASH_ERR_ADDRESS /*指定されたアドレスは無効です。*/

FLASH_ERR_BUSY /*別のフラッシュ動作が処理中か、モジュールが初期化されていません。*/

FLASH ERR FAILURE /*イレーズ失敗。シーケンサがリセットされました。または、*/

/*コールバック関数が登録されていません(BGO/ノンブロッキングモードが有効な場合)。 */

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

コードフラッシュの隣接するブロック、またはデータフラッシュメモリのブロックをイレーズします。 ブロックサイズは MCU のタイプによって異なります。例えば、RX111 では、コードフラッシュ、データフラッシュともにブロックサイズは 1K バイトです。RX231 および RX23T では、コードフラッシュのブロックサイズは 2K バイト、データフラッシュのブロックサイズは 1K バイトです(RX23T にはデータフラッシュはありません)。これらのサイズを定義するために、コードフラッシュにはFLASH_CF_BLOCK_SIZE が、データフラッシュには FLASH_DF_BLOCK_SIZE が提供されます。

列挙型"flash_block_address_t"は、r_bsp モジュールで指定された MCU デバイスのメモリ設定を基に、コンパイル時に設定されます。

APIが BGO/ノンブロッキングモードで使用される場合、指定された番号のブロックがイレーズされた後に FRDYI 割り込みが発生し、コールバック関数が呼び出されます。

Reentrant

この関数は再入不可です。

Example

```
flash_err_t err;

/* データフラッシュブロック 0、1 をイレーズ */
err = R_FLASH_Erase(FLASH_DF_BLOCK_0, 2);

/* エラーの確認 */
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
. . . .
}
```

Special Notes:

コードフラッシュのブロックをイレーズするためには、イレーズする領域は書き換え可能な領域でなければなりません。フラッシュタイプ1は、この指定にアクセスウィンドウを使用します。その他のタイプでは、ロックビットをオフにしてこれに対応してください。

3.5 R_FLASH_BlankCheck()

コードフラッシュ、またはデータフラッシュの指定された領域がブランクかどうかを判定します。

Format

Parameters

num bytes

address

ブランクチェックする領域のアドレス。この機能は MCU によって、データフラッシュ、コードフラッシュのいずれか、または両方に対応するもの、あるいは、いずれにも対応しないものがあります。

フラッシュタイプ 1、3、4 では、この引数でブランクチェックを実施するバイト数を示します。バイト数には、データフラッシュアドレスの場合は FLASH_DF_MIN_PGM_SIZE の倍数を、コードフラッシュアドレスの場合は FLASH_CF_MIN_PGM_SIZE の倍数を指定します。これらは MCU ごとに r_flash_rx\subseterstargets\subs

タイプ 1 では、"address + num_bytes"が、256K の境界を越えないようにしてください。

*blank check result

API で設定されるポインタ。設定内容はブロッキングモード(BGO モードでない)でのブランクチェックの結果です。

Return Values

FLASH SUCCESS /*正常動作(BGO モードが有効な場合、動作が正常に */

/*開始されたことを意味します。) */

FLASH_ERR_FAILURE /*ブランクチェック失敗。シーケンサがリセットされました。または、*/

/*コールバック関数が登録されていません (BGO モード、かつ */

/*フラッシュ割り込みが有効な場合)。 */

FLASH_ERR_BUSY /*別のフラッシュ動作が処理中か、モジュールが初期化されていません。*/

FLASH_ERR_BYTES /* "num_bytes"が大きすぎる、最小プログラムサイズの倍数でない、*/

/*最大範囲を超えている、のいずれかのエラーです。*/

FLASH_ERR_ADDRESS /*無効なアドレスが入力されました。または、アドレスが */

/*最小プログラムサイズで割り切れません。*/

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

プログラム対象のフラッシュ領域はブランクでなければなりません。

ブロッキングモードで動作時、ブランクチェックの結果は"blank_check_result"に入ります。この変数は $flash_res_t$ 型で、 $r_sflash_rx_if.h$ で定義されます。API が BGO/I ンブロッキングモードで使用される場合、ブランクチェック完了後、ブランクチェックの結果がコールバック関数の引数として渡されます。

Reentrant

この関数は再入不可です。

Example: フラッシュタイプ 1、3、4

第2引数はチェックするバイト数です(FLASH_DF_MIN_PGM_SIZE の倍数でなければなりません)。

```
flash_err_t err;
flash_res_t result;

/* データフラッシュブロック 0 の最初の 64 バイトをブランクチェック */
err = R_FLASH_BlankCheck((uint32_t)FLASH_DF_BLOCK_0, 64, &result);
if (err != FLASH_SUCCESS)
{
    /*エラー処理 */
}
else
{
    /* チェック結果 */
    if (FLASH_RES_NOT_BLANK == result)
    {
        /* ブロックがブランクでない場合の処理 */
        . . .
    }
    else if (FLASH_RES_BLANK == ret)
    {
        /* ブロックがブランクの場合の処理 */
        . . .
    }
}
```

Special Notes:

なし

3.6 R FLASH Write()

コードフラッシュ、またはデータフラッシュを書き換えます。

Format

Parameters

src_address

フラッシュに書き込むデータを格納したバッファへのポインタ。

dest address

データを書き換えるコードフラッシュ、またはデータフラッシュ領域へのポインタ。アドレスには、最小プログラムサイズで割り切れる値を指定します。下記の「Description」に本引数の制限事項を示します。

num bytes

"src_address"で指定したバッファに含まれるバイト数。この値は、プログラム対象の領域の最小プログラムサイズの倍数となります。

Return Values

FLASH_SUCCESS /*正常動作(BGO/ノンブロッキングモードの場合、動作が正常に */

/*開始されたことを意味します。) */

FLASH_ERR_FAILURE /*プログラム失敗。書き込み先アドレスが、アクセスウィンドウ、または

*/

/*ロックビットで制御されている可能性があります。またはコールバック*/

/*関数が存在しません(BGO モード、 かつフラッシュ割り込み有効時)。*/

FLASH_ERR_BUSY /*別のフラッシュ動作が処理中か、モジュールが初期化されていません。*/

FLASH_ERR_BYTES /* 指定されたバイト数が最小プログラムサイズの倍数でないか、*/

/*最大範囲を超えています。*/

FLASH ERR ADDRESS /*無効なアドレスが入力されました。または、アドレスが */

/*最小プログラムサイズで割り切れません。*/

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

フラッシュメモリを書き換えます。フラッシュ領域に書き込む前に、対象の領域はイレーズしておく必要があります。

書き換えを行う際は、最小プログラムサイズで割り切れるアドレスから開始してください。また、書き込むバイト数は最小プログラムサイズの倍数としてください。最小プログラムサイズは、使用する MCU パッケージ、およびコードフラッシュ、データフラッシュのいずれを書き換えるかによって変わります。

コードフラッシュにデータを書き込む領域は、書き換え可能な領域 (アクセスウィンドウ、またはロック ビットでアクセス許可設定) でなければなりません。

API が BGO/ノンブロッキングモードで使用される場合、すべての書き込みが完了すると、コールバック関数が呼び出されます。

Reentrant

この関数は再入不可です。

Example

```
flash_err_t err;
uint8_t write_buffer[16] = "Hello World...";

/* 内部メモリにデータを書き込む */
err = R_FLASH_Write((uint32_t)write_buffer, dst_addr, sizeof(write_buffer));

/* エラーの確認 */
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
. . . .
}
```

Special Notes:

FLASH_DF_MIN_PGM_SIZE には、データフラッシュの最小プログラムサイズを定義します。 FLASH CF MIN PGM SIZE には、コードフラッシュの最小プログラムサイズを定義します。

3.7 R_FLASH_Control()

プログラム、イレーズ、ブランクチェック以外の機能を組み込みます。

Format

Parameters

cmd

実行するコマンド

*pcfg

コマンドに要求される設定用引数。コマンドの要求がない場合は NULL で構いません。

Return Values

FLASH_SUCCESS /*正常動作(BGO モードの場合、動作が正常に開始されたことを */

/*意味します。) */

FLASH ERR BYTES /*ブロック数が最大範囲を超えています。*/

FLASH_ERR_ADDRESS /*コード/データフラッシュのブロックの開始アドレスが無効です。*/

FLASH_ERR_NULL_PTR /*設定用構造体を要求するコマンドで使用する引数 "pcfg"が NULL です。*/

FLASH_ERR_BUSY /*別のフラッシュ動作が処理中か、API が初期化されていません。*/

FLASH ERR LOCKED /*フラッシュの制御回路がコマンドロック状態にあり、*/

/*リセットされました。*/

FLASH_ERR_ACCESSW /*アクセスウィンドウエラー: 指定された領域は不正です。*/

FLASH_ERR_PARAM /*無効なコマンド */

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

本関数は、プログラム、イレーズ、ブランクチェック以外のシーケンサの機能を組み込むための拡張機能です。コマンドのタイプによって、引数の型も異なります。

コマンド	引数	動作
フラッシュタイプ 1、3、4 FLASH_CMD_RESET	NULL	シーケンサをリセットします。処理を中断してリセットするか、処理が完了してからリセットするかは処理内容に依存します。
フラッシュタイプ 1、3、4 FLASH_CMD_STATUS_GET	NULL	API の状態(Busy または Idle)を返します。
フラッシュタイプ 1、3、4 FLASH_CMD_SET_BGO_CALLBACK	flash_interrupt_config_t *	コールバック関数を登録します。
フラッシュタイプ 1、4 FLASH_CMD_ACCESSWINDOW_GET	flash_access_window_config_t *	コードフラッシュのアクセスウィンドウ の境界を返します。

コマンド	引数	動作
フラッシュタイプ 1、4 FLASH_CMD_ACCESSWINDOW_SET	flash_access_window_config_t *	(タイプ 1、4) コードフラッシュのアクセスウィンドウの境界を設定します。 BGO/ノンブロッキングモードで使用する場合は、アクセスウィンドウの設定後に FRDYI 割り込みが発生し、コールバック関数が呼び出されます。**
フラッシュタイプ 1、4 FLASH_CMD_SWAPFLAG_GET	uint32_t *	スタートアップ領域設定モニタフラグ (SASMF (タイプ 1)、BTFLG (タイプ 4)) の現在の値を読み出します。
フラッシュタイプ 1、4 FLASH_CMD_SWAPFLAG_TOGGLE	NULL	スタートアッププログラム領域をトグルします。RAMに配置された関数で領域を切り替えます。次のリセットで有効になります。BGO/ノンブロッキングモードで使用する場合は、領域の切り替え後にFRDYI割り込みが発生し、コールバック関数が呼び出されます。**
フラッシュタイプ 1、4 FLASH_CMD_SWAPSTATE_GET	uint8_t *	スタートアップ領域選択ビットの現在の 値(SAS の値)を読み出します。
フラッシュタイプ 1、4 FLASH_CMD_SWAPSTATE_SET	uint8_t *	スタートアップ領域選択ビット (FISR.SAS)の値を、r_flash_rx_if.h で定義して設定します。 #define (value) FLASH_SAS_EXTRA (0) FLASH_SAS_DEFAULT (2) FLASH_SAS_ALTERNATE (3) FLASH_SAS_SWITCH_AREA (4) FLASH_SAS_EXTRA、 FLASH_SAS_DEFAULT、または FLASH_SAS_LTERNATE が設定された場合、値はFISR.SAS に直接設定され、その値によって領域が切り替えられます。 FLASH_SAS_SWITCH_AREA が設定された場合、領域が即座に切り替えられます。切り替えは RAM に配置された関数で行います。リセット後の領域はFLASH_SAS_EXTRA で指定された領域となります。

コマンド	引数	動作
フラッシュタイプ 3 FLASH_CMD_LOCKBIT_READ	flash_lockbit_config _t *	指定したブロックのロックビット情報 (FLASH_RES_LOCKBIT_STATE_PROTECTED 、または FLASH_RES_LOCKBIT_STATE_NON_ PROTECTED)が引数に設定されます。
フラッシュタイプ3 FLASH_CMD_LOCKBIT_WRITE	flash_lockbit_config _t *	指定したブロックアドレスを先頭に、指定したブロック数に対して、ロックビットを設定します。
フラッシュタイプ3 FLASH_CMD_LOCKBIT_ENABLE	NULL	ロックビットが設定されたブロックのイレーズ/ プログラムを禁止します。
フラッシュタイプ 3 FLASH_CMD_LOCKBIT_DISABLE	NULL	ロックビットが設定されたブロックのイレーズ/ プログラムを許可します。 注: ブロックをイレーズするとロックビットがク

		リアされます。
フラッシュタイプ 3、4	uint32_t *	FCLK の動作速度 (Hz)。実行時にクロック速度を
FLASH_CMD_CONFIG_CLOCK		変更する場合にのみ呼び出しが必要です。
RX24T、RX24U、RX65x、RX66T、RX72T	NULL	コードフラッシュのキャッシュを許可にします。
FLASH_CMD_ROM_CACHE_ENABLE		(最初にキャッシュを無効化します。)
RX24T、RX24U、RX65x、RX66T、RX72T	NULL	コードフラッシュのキャッシュを禁止にします。
FLASH_CMD_ROM_CACHE_DISABLE		コードフラッシュを書き換える前に呼び出してく ださい。
RX24T、RX24U、RX65x、RX66T、RX72T	uint8_t *	キャッシュが許可の場合は引数に"1"が設定されま
FLASH_CMD_ROM_CACHE_STATUS		す。 キャッシュが禁止の場合は"O"が設定されま す。
RX66T、RX72T	flash_non_cached_t	コードフラッシュのキャッシュを無効にする領域
FLASH_CMD_SET_NON_CACHED_RANG	*	0の範囲を設定します。
E0		キャッシュが許可の状態で、本コマンドを実行す ると、一時的にキャッシュを禁止にします。
DV00T DV70T		
RX66T、RX72T FLASH CMD SET NON CACHED RANG	flash_non_cached_t *	コードフラッシュのキャッシュを無効にする領域 1 の範囲を設定します。
E1		1 の戦闘と改定しより。 キャッシュが許可の状態で、本コマンドを実行す
		ると、一時的にキャッシュを禁止にします。
RX66T、RX72T	flash_non_cached_t	キャッシュを無効にしている領域 0 の設定を読み
FLASH_CMD_GET_NON_CACHED_RANG	*	出します。
E0		
RX66T、RX72T	flash_non_cached_t	キャッシュを無効にしている領域1の設定を読み
FLASH_CMD_GET_NON_CACHED_RANG	*	出します。
RX65N (コードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の製品)	NULL	スタートアップバンクを切り替えます。次のリセットで有効になります。BGO/ノンブロッキン
T.SM ハイト以上の製品) FLASH_CMD_BANK_TOGGLE		セットで有効になります。BGO/ノンプロッキン グモードで使用する場合は、バンク選択レジスタ
T LAGIT_UND_BANK_TOGGLE		設定後に FRDYI 割り込みが発生し、コールバッ
		ク関数が呼び出されます。**
RX65N(コードフラッシュメモリ容量が	flash_bank_t *	現在の BANKSEL 値を読み出します(バンクとア
1.5M バイト以上の製品)		ドレスは次のリセットで有効になる)。
FLASH_CMD_BANK_GET		

**これらのコマンドは、BGO(割り込み)モード時でも完了するまでブロックします。これはフラッシュの構成を変える間、必要な処理です。BGOモードで完了時もコールバック関数は引き続き呼び出されます。

Reentrant

本関数は再入不可です。ただし、FLASH_CMD_RESET コマンドは例外で、いつでも実行が可能です。

Example 1: BGO モードで、ポーリングを行う

フラッシュの動作完了待機中に、別の動作を行わずにループすることは、ブロッキングモードの通常動作と機能的に同じことです。フラッシュ動作の完了待機中に、別の処理を実行する必要がある場合に BGOモードを使用します。

```
flash_err_t err;

/* 全データフラッシュをイレーズ */
R_FLASH_Erase(FLASH_DF_BLOCK_0, FLASH_NUM_BLOCKS_DF);

/* 動作完了の待機 */
while (R_FLASH_Control(FLASH_CMD_STATUS_GET, NULL) == FLASH_ERR_BUSY)
{
/* 重要なシステムチェックをここで実施 */
}
```

Example 2: フラッシュタイプ 1、3、4 で割り込みを使って BGO モードを設定する

FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO、または FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO が"1"の場合、BGO/ノンブロッキングモードが有効になります。コードフラッシュの書き換え時、可変ベクタテーブルを RAM に再配置します。また、プログラム/イレーズ/ブランクチェックの前にコールバック関数を登録する必要があります。

```
void func(void)
 flash_err_t err;
 flash_interrupt_config_t cb_func_info;
              *pvect_table;
 uint32_t
 /* 可変ベクタテーブルを RAM に再配置 */
 /* フラッシュレディ割り込み関数のアドレスを ram_vect_table[23]に直接設定することもできる。ユーザシ
 ステムに応じて適切な方法を検討してください。*/
 pvect_table = (uint32_t *)__sectop("C$VECT");
 ram_vect_table[23] = pvect_table[23]; /* FRDYI割り込み関数コピー */
 set_intb((void *)ram_vect_table);
 /* API の初期設定 */
 err = R_FLASH_Open();
 /* エラーの確認 */
 if (FLASH_SUCCESS != err)
   ...(省略)
 /* コールバック関数と割り込み優先レベルの設定 */
 cb_func_info.pcallback = u_cb_function;
 cb_func_info.int_priority = 1;
 err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_SET_BGO_CALLBACK,(void *)&cb_func_info);
 if (FLASH_SUCCESS != err)
  printf("Control FLASH_CMD_SET_BGO_CALLBACK command failure.");
 /* コードフラッシュ上で動作 */
 do_rom_operations();
 ... (省略)
#pragma section FRAM
void u_cb_function(void *event) /* コールバック関数 */
 flash_int_cb_args_t *ready_event = event;
 /* ISR コールバック関数の処理 */
}
```

```
void do_rom_operations(void)
{

/* コードフラッシュアクセスウィンドウの設定、スタートアップ領域フラグのトグル、ブートブロックの切り替え、
イレーズ、ブランクチェック、またはコードフラッシュのプログラムの処理をここに記載 */

... (省略)
}
#pragma section
```

Example 3: 現在のアクセスウィンドウの範囲を取得する

```
flash_err_t err;
flash_access_window_config_t access_info;

err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ACCESSWINDOW_GET, (void *)&access_info);
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
    printf("Control FLASH_CMD_ACCESSWINDOW_GET command failure.");
}
```

Example 4: コードフラッシュのアクセスウィンドウを設定する(フラッシュタイプ 1 および 4) 領域保護は、コードフラッシュのブロックの不正な書き換え、またはイレーズを防ぐために使用されます。以下の例では、ブロック 3 のみに書き換えを許可します(デフォルトではすべてのブロックが書き込み

不可の状態です)。

```
flash_err_t err;
flash_access_window_config_t access_info;

/* コードフラッシュブロック 3 への書き込み許可 */

access_info.start_addr = (uint32_t) FLASH_CF_BLOCK_3;
access_info.end_addr = (uint32_t) FLASH_CF_BLOCK_2;
err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ACCESSWINDOW_SET, (void *)&access_info);
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
    printf("Control FLASH_CMD_ACCESSWINDOW_SET command failure.");
}
```

Example 5: 選択中のスタートアップ領域の値を取得する

以下の例では、スタートアップ領域設定モニタフラグ(FSCMR.SASMF)の値の読み込み方法を示します。

```
uint32_t swap_flag;
flash_err_t err;

err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_SWAPFLAG_GET, (void *)&swap_flag);
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
   printf("Control FLASH_CMD_SWAPFLAG_GET command failure.");
}
```

Example 6: 選択中のスタートアップ領域を切り替える

以下の例では、スタートアップ領域のトグル方法を示します。RAM に配置された関数を使って領域を切り替えます。

```
flash_err_t err;

/* 2つのアクティブ領域の切り替え */

err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_SWAPFLAG_TOGGLE, FIT_NO_PTR);
if(FLASH_SUCCESS != err)
{
   printf("Control FLASH_CMD_SWAPFLAG_TOGGLE command failure.");
}
```

Example 7: スタートアップ領域選択ビットの値を取得する

以下の例では、スタートアップ領域選択ビット(FISR.SAS)の現在の値を読み込む方法を示します。

```
uint8_t swap_area;
flash_err_t err;

err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_SWAPSTATE_GET, (void *)&swap_area);
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
printf("Control FLASH_CMD_SWAPSTATE_GET command failure.");
}
```

Example 8: スタートアップ領域選択ビットの値を設定する

以下の例では、スタートアップ領域選択ビット(FISR.SAS)の設定方法を示します。RAMに配置された関数を使って領域を切り替えます。リセット後は"FLASH_SAS_EXTRA"で指定された領域が使用されます。

```
uint8_t swap_area;
flash_err_t err;

swap_area = FLASH_SAS_SWITCH_AREA;
err = R_FLASH_Control(FLASH_CMD_SWAPSTATE_SET, (void *)&swap_area);
if (FLASH_SUCCESS != err)
{
   printf("Control FLASH_CMD_SWAPSTATE_SET command failure.");
}
```

Example 9: コードフラッシュの書き換え時にキャッシュの設定をする

以下の例では、コードフラッシュの書き換え時にキャッシュコマンドを使用する方法を示します。

```
uint8_t status;

/* アプリケーションの開始に向けてキャッシュを許可にする */
R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ROM_CACHE_ENABLE, NULL);

/* メインコードをここに記載(任意でキャッシュが許可かどうかを検証) */
R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ROM_CACHE_STATUS, &status);
if (status != 1)
{
    // エラー処理
}

/* コードフラッシュ書き換えの準備 (キャッシュを禁止にする) */
R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ROM_CACHE_DISABLE, NULL);

/* イレーズ、プログラム、ベリファイなどのコードをここに記載 */

/* キャッシュを再度許可にする */
R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ROM_CACHE_ENABLE, NULL);
```

Example 10: コードフラッシュの特定範囲のキャッシュを無効にする

以下の例では、コードフラッシュの特定範囲のキャッシュを無効にする方法を示します。キャッシュを無効にできる範囲は2つまで設定でき、その2つの範囲は重複していても問題ありません。

```
flash_non_cached_t range;
uint8_t status;

/* FLASH_CF_BLOCK_10 の先頭から 1k バイトの範囲で、命令キャッシュ(IF)とデータキャッシュ(OA)
* のキャッシュを無効に設定する。*/
range.start_addr = (uint32_t)FLASH_CF_BLOCK_10;
range.size = FLASH_NON_CACHED_1_KBYTE;
range.type_mask = FLASH_NON_CACHED_MASK_IF | FLASH_NON_CACHED_MASK_OA;

R_FLASH_Control(FLASH_CMD_SET_NON_CACHED_RANGEO, &range);

/* キャッシュを許可にする *
* キャッシュが許可の状態では、本コマンドは実行不要です。 */
R_FLASH_Control(FLASH_CMD_ROM_CACHE_ENABLE, NULL);

/* RANGEO のキャッシュの設定を取得 */
R_FLASH_Control(FLASH_CMD_GET_NON_CACHED_RANGEO, &range);
```

Special Notes:

なし

3.8 R_FLASH_GetVersion ()

この関数は本 FIT モジュールのバージョン番号を返します。

Format

uint32_t R_FLASH_GetVersion(void);

Parameters

なし

Return Values

バージョン番号

Properties

r_flash_rx_if.h にプロトタイプ宣言されています。

Description

この関数は本 FIT モジュールのバージョン番号を返します。バージョン番号は符号化され、最上位の 2 バイトがメジャーバージョン番号を、最下位の 2 バイトがマイナーバージョン番号を示しています。バージョンが 4.25 の場合は、"0x00040019"が返されます。

Reentrant

この関数は、再入可能(リエントラント)です。

Example

```
uint32_t cur_version;

/* インストールされているフラッシュ FIT のバージョンを取得 */
cur_version = R_FLASH_GetVersion();

/* 本アプリケーションを使用するのに有効なバージョンかどうかを確認 */
if (MIN_VERSION > cur_version)
{

/* 警告: 本フラッシュ FIT のバージョンでは以降のバージョンでサポートされている XXX 機能を
サポートしていません。本アプリケーションでは XXX 機能を使用します。*/
...
}
```

Special Notes:

この関数は "#pragma inline" を使用してインライン化されています。

4. デモプロジェクト

デモプロジェクトはスタンドアロンプログラムです。デモプロジェクトには、FIT モジュールとそのモジュールが依存するモジュール(例: r_bsp)を使用する main()関数が含まれます。デモプロジェクトの標準的な命名規則は、<module>_demo_<board>となり、<module>は周辺の略語(例: s12ad、cmt、sci)、<board>は標準 RSK(例: rskrx113)です。例えば、RSKRX113 用の s12ad FIT モジュールのデモプロジェクトは s12ad_demo_rskrx113 となります。同様にエクスポートされた.zip ファイルは <module>_demo_<board>.zip となります。例えば、zip 形式のエクスポート/インポートされたファイルは s12ad_demo_rskrx113.zip となります。

4.1 flash demo rskrx113

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、ブランクチェック、プログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX113

4.2 flash_demo_rskrx231

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、ブランクチェック、プログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」→「C/C++ビルド」→「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」→「セクション」→「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX231

4.3 flash demo rskrx23t

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、ブランクチェック、プログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX23T

4.4 flash demo rskrx130

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによって、フラッシュのイレーズ、ブランクチェック、プログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」→「C/C++ビルド」→「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」→「セクション」→「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX130

4.5 flash demo rskrx24t

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、ブランクチェック、プログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX24T

4.6 flash demo rskrx65n

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、ブランクチェック、プログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX65N

4.7 flash_demo_rskrx24u

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、およびプログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」→「C/C++ビルド」→「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」→「セクション」→「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX24U

4.8 flash_demo_rx65n2mb_bank1_bootapp / _bank0_otherapp

本デモは下記の対応ボードを使ったデュアルバンク動作のシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによって、次のリセットで BANKSEL レジスタを読み出して、バンク/アプリケーションを切り替えます。バンク 1 のアプリケーション実行時には LED1 を、バンク 0 のアプリケーション実行時には LED0 をそれぞれ点滅させます。

設定と実行:

- 1. flash_demo_rx65n2mb_bank1_bootapp をビルドして、flash_demo_rx65n2mb_bank0_otherapp をビルドします。
- 2. (HardwareDebug) flash_demo_rx65n2mb_bank1_bootapp をダウンロードします(デバッグ設定で他方のアプリケーションもダウンロードされます)。
- 3. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。
- 4. LED1 が点滅していることを確認してください。ボードのリセットスイッチを押します。LED0 が点滅していることを確認してください(バンクが切り替えられ、他方のアプリケーションが実行される)。必要に応じて、リセット処理を継続してください。

対応ボード

RSKRX65N-2MB

4.9 flash_demo_rskrx64m

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによって、フラッシュのイレーズ、およびプログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「出力」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX64M

4.10 flash demo rskrx64m runrom

本デモは下記の対応ボードを使ったシンプルなデモです。他のデモとの違いは、RX64M機能を活用し、 片方のコードフラッシュ領域から別の領域へのイレーズ/プログラム中にアプリケーションを実行できる点 にあります(他のほとんどの MCU は、コードフラッシュのイレーズ/プログラム中に実行可能なコードを RAM に配置する必要があります)。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、およ びプログラムを行います。プログラム関数の動作は、データのリードバックにより検証します。このデモで は、コードフラッシュのイレーズ/プログラムのサポート用に設定された一般的なリンカ(RAM 配置)は不 要で、FLASH_CFG_CODE_FLASH_RUN_FROM_ROM が"r_flash_rx_config.h"で 1 に設定されることに注 意してください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX64M

4.11 flash demo rskrx66t

本デモは e^2 studio v6.2.0 と下記の対応ボードを使用したシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、およびプログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「シンボルファイル」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX66T

4.12 flash demo rskrx72t

本デモは e^2 studio v7.0.0 と下記の対応ボードを使用したシンプルなデモです。デモでは、ブロッキングモードによってフラッシュのイレーズ、およびプログラムを行います。プログラム関数では、データをリードしてプログラムしたデータと比較します。コードフラッシュを書き換えるときは、"pragma section FRAM"と、リンカの対応セクションの定義(プロジェクトの「プロパティ」 \rightarrow 「C/C++ビルド」 \rightarrow 「設定」を選択し、「ツール設定」タブで「Linker」 \rightarrow 「セクション」 \rightarrow 「シンボルファイル」を参照)を事前にご確認ください。

設定と実行:

- 1. サンプルコードをコンパイルしてダウンロードします。
- 2. ソフトウェアを実行します。プログラムが main()で停止した場合、F8 を押して再開します。

対応ボード

RSKRX72T

4.13 ワークスペースにデモを追加する

デモプロジェクトは、本アプリケーションノートで提供されるファイルの FITDemos サブディレクトリにあります。ワークスペースにデモプロジェクトを追加するには、「ファイル」→「インポート」を選択し、「インポート」ダイアログから「一般」の「既存プロジェクトをワークスペースへ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。「インポート」ダイアログで「アーカイブ・ファイルの選択」ラジオボタンを選択し、「参照」ボタンをクリックして FITDemos サブディレクトリを開き、使用するデモの zip ファイルを選択して「完了」をクリックします。

e² studio v6.0.0 以降を使用している場合、プロジェクトを正しくビルドするためには、インポートした後にプロジェクトを更新する必要があります。これは、プロジェクトフォルダを右クリックし、[古いe2studio プロジェクトを更新]を選択することで行います。



4.14 デモのダウンロード方法

デモプロジェクトは、RX Driver Package には同梱されていません。デモプロジェクトを使用する場合は、個別に各 FIT モジュールをダウンロードする必要があります。「スマートブラウザ」の「アプリケーションノート」タブから、本アプリケーションノートを右クリックして「サンプル・コード(ダウンロード)」を選択することにより、ダウンロードできます。

5. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル:ハードウェア (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル:開発環境 RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3248)

改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.70	Oct.31.16	_	初版発行
		プログラム	イレーズの境界の問題を修正(RX64M/71M)
			R_DF_Write_Operation()のビッグエンディアンの問題を修正
			(フラッシュタイプ 1)
			FLASH_xF_BLOCK_INVALID の値を修正(フラッシュタイプ 3)
			FLASH_CF_BLOCK_INVALID を修正 (RX210/21A/62N/630/63N/63T(フラッシュタイプ 2))
			ロックビットの有効/無効コマンドを修正
			ロックビットの書き込み/読み出し、BGO のサポートを追加(RX64M/71M)
			フラッシュへの大容量の書き込みに失敗しているにも関わらず、正常復帰するという問題(不正な時間切れ処理)を修正(RX64M/71M)
			R_FLASH_Control (FLASH_CMD_STATUS_GET, NULL)が 常に BUSY を返すという問題に対応(RX64M/71M)。 #if を追加して、BGO モードでない場合は ISR コードを省く
			ようにしました。
			ブランクチェック結果が不正となる問題を修正
			(フラッシュタイプ 2)
2.00	Feb.17.17	_	FIT モジュールの RX230 グループ、RX24T グループ(いずれもフラッシュタイプ 1)対応。
		3	「1.2 BSP の使用に関するオプション」: FIT BSP を使用しない場合の説明を追加。
		10	「2.12 Flash FIT モジュールの追加方法」: 内容改訂。
		フ゜ロク゛ ラム	フラッシュタイプ 1 対象の定義
			"FLASH_CF_LOWEST_VALID_BLOCK" &
			"FLASH_CF_BLOCK_INVALID"の値を変更。
2.10	Feb.17.17	_	FIT モジュールの RX24T グループ(ROM 512KB 版を含む)、RX24U グループ(いずれもフラッシュタイプ 1)対応。
		プ ログ ラム	全フラッシュタイプで小さいバグを修正し、パラメータ
			チェックをさらに追加。変更の詳細は、r_flash_rx_if.h の「History」を参照してください。
3.00	Apr.28.17	7, 8	「2.9 コードサイズ」にて ROM および RAM のサイズを変更
		プ゚ログ ラム	♥ タイプ 1、3、4 に共通のコードをまとめ、動作が明確にな
		7 - 7 /4	るようにハイレベルコードの構成を見直し。
3.10	Apr.28.17		FIT モジュールでコードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイ
		14	ト以上の RX65N グループの製品に対応。
		28	「2.16 デュアルバンクの動作」を追加。
		07	「3.6 R_FLASH_Control()」の Description にコマンド
		37	「FLASH_CMD_BANK_xxx"を追加。
			「4.8 flash_demo_rskrx65n2mb_bank1_bootapp / _bank0_otherapp」を追加。

			改訂内容
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1101.	2017.1	プ゚ログラム	コマンド "FLASH_CMD_BANK_xxx"を追加。
		, ., ,,	フラッシュが非常に遅い場合、フラッシュタイプ 1 API 呼び
			出しから"BUSY"が返る可能性があるため、その問題に対
			応。
			フラッシュタイプ3の初期化中に ECC フラグのクリアを追
			加。
3.20	Aug.11.17	1,4,6,7	FIT モジュールの RX130-512KB 対応。
		9-17	e² studio の変更点を追加。
		38,39	mcu_config.h が必要なのは BSP を使用しない場合にのみに 変更。
		フ゜ロク゛ラム	RX65N-2M デュアルモードで、バンク 0 での実行時にバン
			クスワップを実行するとアプリケーションの実行が失敗する
			ことがあるバグを修正。
3.30	Dec.08.17	9,20	FLASH_ERR_ALREADY_OPEN を追加。
		19,21	R_FLASH_Close()を追加。
		35 26	フラッシュタイプ2のアクセスウィンドウ設定例を追加。
			フラッシュタイプ2のブランクチェック例を追加。
3.40	Jul.17.18	1,5,6	RX66T のサポートを追加。
			RX111 グループおよび RX24T グループにおいて、ROM サ
		45	イズが 256K/384K バイト製品のサポートを追加。
		15	セクション 2.14 の表番号を更新。
		15-16	セクション 2.15 に割り込みイベント列挙型を追加。
		44-46	RDKRX63N、RSKRX66T 用のデモ、RSKRX64M 用の 2 つ のデモを追加。
		フ゜ロク゛ラム	FPCKAR レジスタが Open()で設定されない RX64M/71M の
		,, ,	バグを修正。
3.41	Nov.08.18	34	R_FLASH_Control()の Description に以下のコマンドを追加
			"FLASH_CMD_SET_NON_CACHED_xxxx"
			"FLASH_CMD_GET_NON_CACHED_xxxx"
		41	追加コマンドの使用例を追加
		プログラム	FIT モジュールのサンプルプログラムをダウンロードするた
			めのアプリケーションノートのドキュメント番号を xml
			ファイルに追加。
3.42	Feb.12.19	44-47	4.1~4.12 のタイトル誤記修正
3.50	Feb.26.19	1,5,6,34	RX72T のサポートを追加。
		49 プログラム	RSKRX72T 用のデモを追加。
) H))A	RX210 グループにおいて、ROM サイズが 768K/1M バイト 製品での書き込みおよびイレーズできないバグを修正。
4.00	Apr.19.19		GCC/IAR コンパイラのサポートを追加。
4.00	Αρι.19.19	1,6	対象デバイスから以下のフラッシュタイプ2のデバイスを
		,,,	削除。
			RX210、RX21A、RX220、RX610、RX621、RX62N、
			RX62T、RX62G、RX630、RX631、RX63N、RX63T
		1	関連するアプリケーションノートから以下を削除
			e ² studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology
			CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology
			Renesas e ² studio スマート・コンフィグレータ ユーザー ガイド
		7	カイト FLASH_CFG_USE_FIT_BSP を削除。
I	1	<u> </u>	

		T	
		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
			FLASH_CFG_FLASH_READY_IPL を削除。
			FLASH_CFG_IGNORE_LOCK_BITS を削除。
			FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO の説明を追加
			FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO の説明を追加
		9-12	「2.9 コードサイズ」の章を更新。
		13	「2.11 戻り値」の章から不要となった以下の戻り値を削除
			FLASH_ERR_ALIGNED
			FLASH_ERR_BOUNDARY
			FLASH_ERR_OVERFLOW
		14	「2.12 FLASH FIT モジュールの追加方法」の章を更新。
			「2.13 既存のユーザプロジェクトと組み合わせた使用方法」
			の章を追加。
		15	「2.14 RAM からコードを実行してコードフラッシュを書き
			換える」の章の構成を以下のように見直し更新。
			「2.14.1 Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for
			RX Family を使用する場合」、
			「2.14.2 GCC for Renesas RX を使用する場合」、
			「2.14.3 IAR C/C++ Compiler for Renesas RX を使用する場
			合」
		26	「2.18.4 エミュレータのデバッグ設定」の章を追加。
		プログラム	GCC/IAR コンパイラのサポートを追加に伴う変更。
			FLASH_CFG_USE_FIT_BSP の削除に伴う変更。
			FLASH CFG FLASH READY IPLの削除に伴う変更。
			FLASH_CFG_IGNORE_LOCK_BITS の削除に伴う変更。
			対象デバイスからフラッシュタイプ2のデバイスを削除。
			FLASH_ERR_ALIGNED を削除
			FLASH_ERR_BOUNDARY を削除
			FLASH_ERR_OVERFLOW を削除
			BSP が Rev.5.00 未満の場合にエラー出力する処理を追加。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V_L (Max.) から V_H (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V_L (Max.) から V_H (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、 著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではあ りません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする 場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を 行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客 様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を 行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って ください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に 支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/